

中
1963.7.2
中
中国物理学会

1963年年会論文摘要

(内部資料・注意保存)

一九六三年八月

北京

類 別

- | | |
|----------------------------|---------|
| A. 固体 (固体理論、金屬物理和磁学) | (1) |
| B. 半导体 | (61) |
| C. 光学及波譜学 | (84) |
| D. 电学和声学 | (115) |
| E. 原子、电子和分子 | (128) |
| F. 原子核物理 | (133) |
| G. 基本粒子和場論 | (165) |
| H. 其他 | (182) |

00013

A. 固体（固体理論、金屬物理和磁學）

A1. 量子統計中的線性輸运系数理論

陈式剛（科学院物理所）

在本文中，我們利用 Kubo⁽¹⁾的輸运系数公式及 Van Hove⁽²⁾的趨向平衡理論，普遍地討論了輸运系数中的弛豫過程。在整个討論過程中沒有利用無規相位假設，而粗粒密度假設是自動地包含在被微擾的平衡態密度矩陣中的。

在頻率為 ω 的外場中，得到輸运系数的一般表示式為：

$$L_{BA}(\omega) = f_{BA}(\omega) + \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P}{\omega' - \omega} f_{BA}(\omega') d\omega'$$

$$f_{BA}(\omega) = \frac{4\pi}{\omega} \sin h \frac{1}{Z} \beta \omega \operatorname{Re} \int_C dE B \left[\omega - i \left(\Gamma_{++}(E, \omega) - \right. \right.$$

$$\left. \left. - \tilde{\omega}_{++}(E, \omega) \right) \right]^{-1} A \left(D_-(E, \omega) - D_+(E, \omega) \right) e^{-\beta E}$$

（符号參見〔1〕，〔2〕）。當 $\omega = 0$ 時得到的結果在定性上與波爾茲曼方程一致，與是否作無規相位假設无关。在 $\omega \neq 0$ 時得到的結果與波爾茲曼方程有定性上的差別，這稱為非馬爾科夫效應或記憶效應。它在時間行為上表現為：多個弛豫時間行為的疊加，振盪現象，在輸運過程中出現單個態的弛豫時間。它在頻率行為上有相應的表現。

這種相位关联效應不會被測量儀器破壞，是可以測量的。最直接的是測量它的頻率行為。不過這種效應只有在強作用系統中才有明顯表現，對這種系統的理論分析會遇到相當大的困難。

進一步我們將上述結果推廣到電流算符為非對角的輸運過程中去，作為一個具體例子討論了強磁場下橫向輸運過程。在討論中指出為什麼在這情況下不需要解波爾茲曼型的方程，只要用微擾法就能給出正確的結果。此外討論了其他較具體的問題，指出一種正確的消除態密度發散方法會使縱磁阻與橫磁阻之比得到與實驗一致的結果。

參 考 文 獻

〔1〕R. Kubo J. Phys. Soc. Japan **12** 570 (1957)

〔2〕L. Van Hove Physica **21** 517 (1955), **23** 441 (1957)

A2. 量子統計格林函数的微扰結構

陈春先 黃綺* (科学院物理所)

量子时间格林函数应用(包括推迟、超前和因果函数。)在量子体系非平衡过程的一般理論中占重要地位。時間格林函数沒有成熟和方便的微扰理論是这方面前进的障碍。目前已有的一些微扰論分析不但形式十分复杂，而且由于在数学結構上彼此沒有联系很难从統一的觀点加以理解。

本文建立在“复时间”变量平面上的形式微扰論，討論了回路变形和解析延拓的关系。同时广泛的应用了四維图与三維图解法的联系，建立了一种時間格林函数的微扰論規則，并使最近关于時間格林函数微扰論工作納入統一的数学結構。討論了直接作譜函数微扰展开的可能性。对于不含内部自能部分的图，証明了可以把迴路变形到无穷，从而給具体計算提供了相当的便利。此外，文中还討論了所发展的理論对輸运過程理論的意义。

A3. 关于双时格林函数的切断近似

陶瑞宝 (复旦大学)

文章討論了几个主要双时格林函数的正常切断近似，并和寻常費曼图形的比較。对单粒子格林函数：

$$\langle\langle a_k(t)/a_k^+(t') \rangle\rangle = -i\theta(t-t') \left\{ \langle a_k(t)a_k^+(t') \rangle + \langle a_k^+(t')a_k(t) \rangle \right\},$$

作一級及二級切断近似，在一級情况下是哈特里-福克近似，在二級情况下，对正常的微扰効系(非长程和奇性的相互作用)，得到的自能部份就是寻常Dyson方程中正确到二級修正的固有自能部份。

对密度涨落格林函数：

$$\langle\langle \rho_k(t)/\rho_k^+(t') \rangle\rangle = -i\theta(t-t') \left\{ \langle \rho_k(t)\rho_k^+(t') \rangle - \langle \rho_k^+(t')\rho_k(t) \rangle \right\}.$$

$$\rho_k(t) = \sum_p a_{k+p,\sigma}^+(t) a_{p,\sigma}(t).$$

在一級切断近似下，就得到象电子气体中准确到泡沬近似，并且还包含了所有交換的修正，而且每一条内線用哈特里-福克近似代替。

对粒子对格林函数：

$$\begin{aligned} & \langle\langle a_{k-m\downarrow}(t)a_{k+m\uparrow}(t)/a_{k+n\uparrow}^+(t')a_{k-n\downarrow}^-(t') \rangle\rangle = \\ & = -i\theta(t-t') \left\{ \langle a_{k-m\downarrow}(t)a_{k+m\uparrow}(t)a_{k+n\uparrow}^+(t')a_{k-n\downarrow}^-(t') \rangle - \right. \\ & \quad \left. - \langle a_{k+n\uparrow}^+(t')a_{k-n\downarrow}^-(t')a_{k-m\downarrow}(t)a_{k+m\uparrow}(t) \rangle \right\} \end{aligned}$$

所作的一級切斷近似，得到的解就是尋常費曼圖形中的梯形近似。

文章指出，雙時格林函數即使遵循同一种切斷近似的規則，对于不同的格林函數，近似的好壞十分不同。粒子對格林函數的切斷近似，对短程低密度體系較好；而密度漲落格林函數的切斷近似，却对長程高密度體系（象高密度電子氣體）較好。

A4. 关于非理想多費米子体系的微扰理論 (I)

——应用于各向同性相互作用的情况——

陶瑞宝（复旦大学）

从定态薛定谔方程的微扰論出发，直接求出正确到所有級的基态能量的連接图形展式和相应的基态波函数，还求得了弱激发态的能量和波函数，結果与Hugenholtz的一致。

A5. 关于非理想多費米子体系的微扰理論 (II)

——应用于各向異性相互作用的情况——

陶瑞宝；陈開泰；湯祥輝（复旦大学）

文章发展了处理各向異性相互作用多費米子体系的微扰理論。指出，在零溫下关于基态能量的Goldstone 微扰展式的不正确是由于他們用球对称的費米真空态作为出发态来求微扰波函数；而由它出发求得的能量状态，当相互作用是各向異性的时候，并不代表最低的能量状态。用我們的方法，原則上可以严格地找到各向異性相互作用体系的基态。在二級情况下，我們找到的最低能量状态正好和Kohn-Luttinger 从溫度微扰論的零溫極限求得的状态完全一致。我們还論証了：在一般情况下（正确到相互作用的所有級），只要相互作用是各向同性时，对正常的多費米子体系，Goldstone展式的确对应真正的基态。

A6. 关于玻色系的激发能譜及其寿命

龔昌德 邵惠民（南京大学）

1. 形式为

$$H = E_0 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} A_{\alpha\beta} b_{\alpha}^{\dagger} b_{\beta}^{\dagger} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} A_{\alpha\beta}^{*} b_{\alpha} b_{\beta} + \sum_{\alpha\beta} B_{\alpha\beta} b_{\alpha}^{\dagger} b_{\beta} \quad (1)$$

$$A_{\alpha\beta} = A_{\beta\alpha}, \quad B_{\alpha\beta} = B_{\beta\alpha}^{*} \quad (2)$$

的哈密頓（其中 $b_{\alpha}, b_{\alpha}^{\dagger}$ 为玻色子算符）可以用来处理弱激发的互作用玻色系及金属的極性模型理論。波戈留博夫与加布利可夫已建立了对角化这一哈密頓的方法。这一方法首先引入一正則变换將算符 $(b_{\alpha}, b_{\alpha}^{\dagger})$ 变为 $(\xi_{\mu}, \xi_{\mu}^{+})$ ，再对变换系数 (u, v) 建立方程并附加以一定条件，最后由 (u, v) 方程的系数行列式解得 (1) 的能譜。

本文利用格林函数方法，直接从如下因果格林函数

$$G_{\alpha\beta}(t-t') = \langle\langle b_{\alpha}(t), b_{\beta}^{\dagger}(t') \rangle\rangle \quad (3)$$

出发，利用 (1) 式可得 (2) 的解

$$G = -\frac{1}{2\pi} \left[E - B + A(E+B^*)^{-1} A^* \right]^{-1} \quad (4)$$

其中 E 为单位矩阵的 E 倍, A, B 为 (2) 式中的矩阵。矩阵 $G_{\alpha\alpha}$ 的极点即为(1) 的激发谱, 它满足方程

$$\left[E - B + A(E+B^*)^{-1} A^* \right]_{\alpha\alpha} = 0 \quad (5)$$

若取

$$A_{\alpha\beta} = A_{\alpha\beta}^* = 2\beta_k \delta_{kk'}, \quad B_{\alpha\beta} = \alpha_k \delta_{kk'}, \quad \alpha_k = -\frac{k^2}{2m} + \rho_0 v(k), \quad \beta_k = \frac{\rho_0}{2} v(k)$$

则 (1) 式即为波戈留博夫利用近似二次量子化方法所得到的弱激发玻色系的哈密顿。把这数值代入 (5) 得到激发谱

$$E_k = \sqrt{\alpha_k^2 - 4\rho_k^2} = \sqrt{\frac{k^4}{4m^2} + \rho_0^2 v(k)^2} \frac{k^2}{m}$$

与波戈留博夫所得到的相同

2. 近似二次量子化方法不能用来求得能谱的高一级修正以及膺粒子的寿命。目前一般认为 C.T. Беляев 的理论是处理弱耦合玻色系 (玻色气体) 的比较成功的方法。在一阶气体近似下, 他获得了与波戈留博夫同样的结果, 在二阶近似下, 求得激发谱的微小修正及激发的寿命。对于长波激发 (声子) 的衰减正比于声子动量 k 的五次幂。这一衰减与声子的分裂过程有关。但是 Беляev 在计算中利用了图形技术, 即使在二阶近似下, 计算也很繁杂。

本文利用了格林函数方法并采用了波戈留博夫在另一工作中所得到的玻色系哈密顿, 并保留它的和膺粒子分裂过程有关的部份 (长波激发部份) :

$$H = H_0 + H_1.$$

$$H_0 = \sum_k E(k) b_k^\dagger b_k \quad E(k) = \sqrt{\frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{m} \right) + \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right)^2}$$

$$H_1 = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\substack{k_1 k_2 \\ k_1 + k_2 \neq 0}} V_{k_1 k_2} \left(b_{k_1 + k_2}^\dagger b_{k_1} b_{k_2} + b_{k_1}^\dagger b_{k_2}^\dagger b_{k_1 + k_2} \right) \quad (6)$$

其中

$$V_{k_1 k_2} = \frac{\hbar^2}{8m} \left\{ (k_1 \cdot k_2) \frac{\lambda_{k_1 + k_2}}{\lambda_{k_1} \lambda_{k_2}} + \left[k_1 \cdot (k_1 + k_2) \right] \frac{\lambda_{k_2}}{\lambda_{k_1} \lambda_{k_1 + k_2}} + \left[k_2 \cdot (k_1 + k_2) \right] \frac{\lambda_{k_1}}{\lambda_{k_2} \lambda_{k_1 + k_2}} \right\} \lambda_k^4 \left(\frac{N}{V} v(k) + \frac{\hbar^2 k^2}{4m} \right) =$$

$$= \frac{\hbar^2 k^2}{4m}$$

在同样近似下求得了热力学格林函数

$$G_k(t-t') = \langle\langle b_k(t), b_k^\dagger(t') \rangle\rangle$$

的解, 其谱表式

$$G_k(E) = -\frac{1}{2\pi} \frac{1}{E - \epsilon_k - \sum_k(E)} \quad (7)$$

式中

$$\sum_k(E) = 2 \sum_q \frac{V_{k-q,q}^2}{N} \frac{(n_q + n_{k-q} + 1)}{E - \epsilon_{k-q} - \epsilon_q} + 2 \sum_q \frac{V_{k,q}^2}{N} \frac{(n_q - n_{k+q})}{E - \epsilon_{k+q} + \epsilon_q} \quad (8)$$

由(8)(7)立即得激发谱的修正为

$$\tilde{E}_k = \epsilon_k + P \left\{ \sum_q \frac{V_{k-q,q}^2}{N} \frac{(n_q + n_{k-q} + 1)}{E - \epsilon_{k-q} - \epsilon_q} + \sum_q \frac{V_{k,q}^2}{N} \frac{(n_q - n_{k+q})}{E - \epsilon_{k+q} + \epsilon_q} \right\} \quad (9)$$

激发的衰减为

$$\begin{aligned} \gamma_k(\omega) = & \pi \sum_q 2 V_{k-q,q}^2 (n_q + n_{k-q} + 1) \delta(\omega - \epsilon_{k-q} - \epsilon_q) + \\ & + \pi \sum_q 2 V_{k,q}^2 (n_q - n_{k+q}) \delta(\omega - \epsilon_{k+q} + \epsilon_q) \end{aligned} \quad (10)$$

若声子分佈近似地用玻色分佈代入(10)式则可通过积分(10)式求得激发的衰减，特别在绝对零度下我们得到长波激发的衰减为

$$\gamma_k(\epsilon_k) \sim \sqrt{n_0 f_0^3} \frac{\epsilon_k^5}{(n_0 f_0)^4}$$

这一结果与Беляев的结果一致。

A7. 铁磁体中缺陷对自旋波的影响

李隆远 方励之 顾世杰 朱硯磬 (科学院物理所)

这一报告是以下三篇论文：

铁磁体中缺陷对自旋波的影响 (李、方、顾) 立方铁磁体中的自旋波局域模 (李、朱) 和有缺陷铁磁体的中子非弹性散射 (方、顾) 的综合叙述。

晶格中缺陷对于声子或 Bloch 电子的影响，在国际文献中已有不少的理论分析和实验探索。至于缺陷对自旋波的影响，我们尚未见到有任何工作出现。在使用 Heisenberg 交换哈密顿量并只包括近邻作用的前提下，我们考虑一个代位杂质可能引起的自旋波散射和局域模的形成。能级在連續带之外的局域模的出現条件、能級位置和自旋偏離的空間分布通过一含 $z+1$ 个未知元的綫性齐次方程組来求出。这里 z 是晶格的近邻配位数。对于最简单的模型：一維綫性鍊，局域模可能有二个，偶对称模和奇对称模。二者出现在能帶頂以上的条件分别是 $\frac{J' S'}{JS} + \frac{J'}{J} > 2$ ，和 $\frac{J' S'}{JS} > 2$ 。出现在能帶之下的条件是 $J' < 0$ 。这里 S 和 S' 分别为基質原子和杂质原子的自旋， J' 和 J 各为杂质与其近邻之間和一般近邻之間的交换积分。局域模的自旋偏離集中在杂质和其較邻近的原子上，自最近邻向外指数函数地衰減。高度集中的应变和間隙原子，如致使邻近处的交换作用增大或变号都引起局域模的出現。包括磁偶極矩相互作用进行計算的結果，證明了这些局域模并不遭到破坏。

对于三維铁磁晶体，通过对称分析可将 $z+1$ 阶的久期行列式約化为几个低阶的，并求出相应的局域模。例如，在简单立方可能有类 s 型模，类 p 型模（三重簡併）和类 d ， f 型模（二重簡併）。其出現条件、能級高度和自旋偏離的对称分布将在报告时以图表示之。

帶內散射波受到杂质的影响使各个格点上的自旋偏離相互間有了差別，但这一差别的數

量級只达到 $1/N$ 。这里 N 是原子的总数。我們分析了散射模和局域模的波函数，證明它們一起組成总自旋偏離为 1 的元激发态的子空間中的一个正交归一全系。我們計算了有缺陷鐵磁体的中子-自旋波散射，得到非弹性散射的微分截面，肯定了用慢中子的散射实验可能証实局域模的存在。

立方鐵磁体中的类 s 型模最有可能实际觀測到。作为觀測局域自旋波的样品的鐵磁体，其居里点应随滲杂浓度的增加而上升。

A 8. 交換作用漲落所引起的鐵磁共振綫寬

許政一（科学院物理所）

Clogston 等⁽¹⁾最早从磁性离子无序分佈来解释反型尖晶石型鐵氧体的綫寬比磁性离子有序分佈的鐵氧体的綫寬要大得多这一現象。他們考虑了交換积分和膺偶極作用常数的空间涨落，但略去了自旋矩的空间涨落，算得的結果仅膺偶極作用的涨落对共振綫寬有貢献。他們取膺偶極作用常数比單純磁偶極作用常数大二个数量級，才得到与實驗值在数量級上相符的結果。但根据：（1）各向異性理論⁽²⁾及實驗⁽³⁾，（2）鐵氧体在居里溫度以上的順磁共振綫寬的實驗⁽⁴⁾，（3）鐵磁共振綫寬的實驗^{(5), (6)}，膺偶極作用常数該比 Clogston 等所取值小二个数量級。因此膺偶極作用涨落所引起的綫寬要比實驗值小四个数量級，可略去。

若同时考慮交換积分和自旋矩的空间涨落，则交換作用涨落对綫寬也有貢献。我們从以下的等效鐵磁哈密頓量出发：

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 + \hbar\omega' \quad (1)$$

$$\hbar\omega_0 = -g\beta H \sum_i S_{iz} - \sum_{i,j} J_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j + \frac{1}{2} \sum_{i,j} D_{ij} \left[\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{3}{\gamma_{ij}} (\vec{\gamma}_{ij} \cdot \vec{S}_i)(\vec{\gamma}_{ij} \cdot \vec{S}_j) \right], \quad (2)$$

$$\hbar\omega' = g\beta H \sum_i (S_{iz} - S'_{iz}) + \sum_{i,j} J'_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \sum_{i,j} J''_{ij} \vec{S}'_i \cdot \vec{S}'_j. \quad (3)$$

$\hbar\omega_0$ 表示若磁离子有序分佈时的哈密頓量， J_{ij} ， \vec{S}_i 为相应之等效交換积分和自旋矩。 $\hbar\omega'$ 表示磁离子无序分佈所引起的哈密頓量之改正。 J'_{ij} ， \vec{S}'_i 为磁离子无序分佈时的交換积分和自旋矩，均随空间位置变化。 $\hbar\omega_0$ 决定自旋波頻譜， $\hbar\omega'$ 引起自旋波散射。用与 [1] 相同的方法算得綫寬

$$\Delta H = \frac{V}{Na^3} \frac{2c(1-c)^2}{\pi\gamma^2\hbar^2} \left(1 - \sqrt{\sigma}\right)^2 \left(J_{uv} Z S_v\right)^2 \frac{\sqrt{4\pi M}}{H_e^{3/2}} I\left(\frac{H}{4\pi M}, n_t\right). \quad (4)$$

$\sigma = \frac{S_u}{S_v}$ 是二种阳离子的等效自旋之比， J_{uv} 是二者間之等效交換积分， c 为 u 离子波度，

$I\left(\frac{H}{4\pi M}, n_t\right)$ 是 n_t 及 $\frac{H}{4\pi M}$ 的函数，其值介于零与一之間。以上其它符号之意义与 [1] 同。

以上結果对 c 小时适用。但我們將它外推至反型尖晶石型鐵氧化物情形，估計得 $\Delta H \sim 50$ 奥，在数量級上与實驗相符。故可确定交換作用漲落是反型尖晶石型鐵氧化物內稟綫寬大的主要原因。

若 u, v 有一为非磁性离子，则 $J_{uv} = 0$ ；若 u, v 为自旋相等的不同离子，则 $\sigma = 1$ 。由(4)知，在这二种情形 $\Delta H = 0$ ，即交換作用漲落对共振綫寬均无貢獻。从而可解釋无序鋰鐵氧化物和鎂錳鐵氧化物的綫寬特別小的事實。因为对前者， Li^+ 为非磁性离子，其余阳离子为 Fe^{3+} ；对后者， Mg^{2+} 为非磁性离子， Mn^{2+} 和 Fe^{3+} 的自旋都是 $\frac{5}{2}$ 。

参考文獻

- (1) Clogston, A. M. et al., J. Phys. Chem. Solids, 1 (1956), 129.
- (2) Yosida, K. and Tachiki, M., Prog. Theor. Phys. 17 (1957), 331.
- (3) Folen, V. J. and Rado, G. T. J. Appl. Phys. 29 (1958), 438.
- (4) White, R. L. Phys. Rev. 115 (1959), 1519.
- (5) Гуревич, А.Г., Гублер, И.Е. и Титова, А. Г., ФТТ, 3 (1961), 19.
- (6) Denton, R. T. and Spencer, E. G., J. Appl. Phys. 33 (1962), 1300, Suppl.

A9. 关于稀土金属中价电子間的交換作用

荀清泉 曾 琴 常 滿 鐘心剛 徐家振 (吉林大学 物理系)

过渡金属与合金的磁性的本質問題，一直到現在还了解得很少。过去有很多人在交換作用概念的基础上提出了若干交換作用模型来分析过渡金属与合金的磁性，但一般所用的概念和模型都比較粗糙，且缺乏系統的定量計算，往往得不出肯定的結論。因此一直到現在固体中比較完善的交換作用的定量理論还未形成，建立交換作用理論中的一个重要問題，就是价电子間的交換积分的符号与大小。由于这种交換积分的計算比較困难，过去长期以来很少人进行过严格的定量計算，有很多人常常把它作为一个未知参数来討論，其符号与大小只能作为一个假設提出，因此得不出定量的結果和肯定的結論。近年来，有若干作者进行了一些定量計算，但是由于各人所用的关于交換积分的定义不同和所用的电子波函数不同，所得的結論也是不同的。因此，我們認為，进一步研究过渡族金属中价电子間的交換作用，进行系統的計算，以确定有关交換积分的符号和大小，对发展鐵磁性理論是十分重要的。

近两年來有人只对少数鐵族金属的直接交換积分进行了比較系統而严格的計算。至今尚沒有人对稀土金属进行过系統的計算。我們准备对稀土金属原子間价电子的交換作用进行系統的計算，以探討各种金属中交換积分的符号和大小，及其在产生磁性上的作用。

我們先以釔为例来进行系統計算。我們設計了一种簡單的解析原子波函数，按照通常分子結構理論中計算取中心积分的方法，計算了一对Gd原子間的 s-s, s-d, d-d 交換积分与原子間距离的关系，并計算了同一原子中的 s-d, s-f, d-f 交換积分。对两原子間的交換积分分別采用了 Heisenberg 和 Löwdin 关于交換积分的不同定义来进行計算，將两种計算結果

果加以比較。所得結果主要為：

1. s-s交換積分 J_{s-s} ，按 Heisenberg 定義計算是正的，且隨原子間距的增大而減小，但按 Löwdin 定義計算則是負的，且隨原子間距的增大而負值減小。

2. d-d交換積分 $J_{d-d}(\sigma\sigma)$ ，按 Heisenberg 定義計算是正的，隨原子間距的增大而逐漸增大然後又逐漸減小，但按 Löwdin 定義計算則原子間距小時是正的，原子間距大時變為負的。

3. d-d交換積分 $J_{d-d}(\pi\pi)$ ，按 Heisenberg 定義計算，原子間距小時是正的，原子間距大時是負的。但按 Löwdin 定義計算則是負的，原子間距小時負值很大，原子間距增大時負值減少很快。

4. s-d交換積分 J_{s-d} ，按 Heisenberg 定義計算是正的，隨原子間距的增大而逐漸減小；按 Löwdin 定義計算，原子間距小時也是正的，但數值較小，原子間距大時變為負的。

由以上的計算結果表明：

1. 按兩種不同的交換積分定義計算得到的結果有很大的不同。Löwdin 的定義比較嚴格。既然按 Heisenberg 的定義計算有很大的差異，則對嚴格的計算，就不能用這種定義來計算交換積分。

2. 我們所算得的結果與以往的兩種論點不同，一種論點認為直接交換積分 J 总是負的（Zener 的觀點），另一種論點認為直接交換積分 J 在小距離時為負的，距離大時變為正的，並經過一極大後下降至零（Slater 和 Bette 的觀點）。我們算出的 J 強烈地依賴於軌道的角度部分，而結果一般並不與以往的兩種論點一致。

我們根據一種交換作用模型並應用以上計算結果，估計了 Gd 的居里點溫度，結果與實驗值比較接近。

A10. 鉻的d-d、s-d交換作用

吳代鳴、曾令文、周泳娥、靳仲蘭、張家祥、孫伯祥、
馬士寅、張存富（吉林大學、東北物理所）

過渡金屬鐵磁性理論中一個重要問題是3d電子間的交換積分 J_{d-d} 的符號與大小。近年來，不少作者〔1〕對 J_{d-d} 進行了實際計算。由於各人所用的關於 J_{d-d} 的定義及3d電子的波函數不同，所得結論是不同的。其中最有意義的是 Freeman 和 Watson 所作的計算。他們按照 Löwdin 〔2〕最近提出的關於 J_{d-d} 的嚴格定義，採用由 Hartree-Fock 自洽場方法計算出的原子波函數，計算了一對 $\text{Co}(3d^9)$ 原子和一對 Co^{++} 離子的 d-d 交換積分，結果 J_{dd} 是負的。因此，他們認為，過渡金屬中3d電子間的直接交換作用不能產生鐵磁性，從而支持了 Zener 〔3〕提出的關於過渡金屬中 d-d 交換作用是負的，鐵磁性的主要來源是 s-d 交換作用的假定。

我們認為，進一步研究過渡金屬中 d-d、s-d 交換作用的符號及相對大小對發展鐵磁理論具有重大意義。從已有的工作看來，以下三個基本問題還沒有解決：（1）d-d 交換積分是否對不同金屬以及在不同核間距離下都是負的？（2）s-d 交換積分的符號與大小，（3）對於反鐵磁性過渡金屬如 Cr、Mn 等，是否象 Zener 〔3〕所假定的那樣，主要是由 d-d 直接交換作用決定的？

為了探討上述問題，我們針對一对Cr原子進行了計算。我們採用苟清泉、李光伟、金信默〔4〕用變分法計算出的Cr原子的解析波函数，按照通常在量子化學中計算雙中心积分的方法〔5〕計算了相應于Cr晶体中最鄰及次近鄰原子間距離的一對Cr原子間的d-d、s-d交換积分。並且比較了Heisenberg〔6〕和Löwdin〔2〕關於J的不同定義所得的結果。主要結果如：

(1) d-d交換积分是負的，與Freeman Watson的結論一致。仿然stuart Mashall〔1〕的做法，得到平均一對3d電子的交換积分对于最鄰及次近鄰原子間距離下分別為 $J = -9.762 \times 10^{-4}$ (au), -4.064×10^{-4} (au)。因此，Cr中3d電子的直接交換作用是引起反鐵磁性。

(2) s-d交換作用是正的，引起鐵磁性。但其數值要比d-d交換作用小，支持了Zener〔3〕關於Cr的反鐵磁性主要由d-d交換作用產生的假定。

(3) 根據由分子場理論導出的Neil點 T_N 的公式〔1〕算出 $T_N = 430^\circ\text{K}$ 與實驗值 $T_N = 312^\circ\text{K}$ 比較接近。

参 考 文 献

- 〔1〕 E. P. Wohlfartt, Nature 163 57 (1949), H. Kaplan, Phys Rev 81 1038 (1952), R. Stuart and W. Marshall, Phys Rev 120 353 (1960), A. J. Freeman and R. E. Watson, Phys Rev 124 1439 (1962)
- 〔2〕 P. O. Löwdin Rev Mod Phys 34 80 (1962)
- 〔3〕 C. Zener Phys Rev 81 440 (1951), 82 403 (1951), 83 299 (1951), 85 324 (1951)
- 〔4〕 苟清泉、李光伟、金信默第一過渡金屬元素的解析原子波函数（未發表）
- 〔5〕 M. Kotani, A. Amemiya, E. Ishiguro, T. Kimura “Table of molecular integrals” Tokyo. (1955)
- 〔6〕 W. Heisenberg. Z. Phys 49 619 (1928)
- 〔7〕 G. W. Pratt Phys Rev 106 53 (1957)

A11. 鐵磁體的熱力學性質

孫 鑑 黃靜宜 叶紅娟（復旦大學物理系）

利用Malcev變換：

$$S_l^z = -S + b_l^\dagger b_l; S_l^+ = \sqrt{2S} b_l^\dagger; S_l^- = \sqrt{2S} \left(1 - \frac{b_l^\dagger b_l}{2S}\right) b_l \quad (1)$$

將鐵磁系統的Heisenberg交換哈密頓

$$H = g\mu B \sum_l S_l^z - \sum_{l,m} I(l-m) S_l \cdot S_m \quad (2)$$

用b算符表示為：

$$H = -g\mu B S N - S^2 N J(O) + [g\mu B + 2S J(O)] \sum_l b_l^\dagger b_l - 2S \sum_{l,m} I(l-m) b_l^\dagger b_m +$$

$$+ \sum_{l,m} I(l-m) \left[b_l^+ b_m^+ b_m b_m - b_l^+ b_l b_m^+ b_m \right] \quad (3)$$

其中四算符之項对应于自旋波的相互散射，称为“动力学相互作用”。本文导出了b算符的对易关系为：

$$b_l b_m^+ - b_m^+ b_l = \left(1 - \frac{2S+1}{(2S)!} b_l^{2s} b_l^{2s} \right) \delta_{lm}, \quad b_l^{2s+1} = b_l^{2s+1} = 0 \quad (4)$$

所以b、b⁺不再是玻色算符，这是由于自从偏离不能超过2S而引起的，称它为“运动学相互作用”。由于本文同时考虑了动力学及运动学相互作用，因而由此建立的理論不受溫度的限制，能够計算任意自旋数值 (S≥1) 的鐵磁体在各种溫度范围内的热力学量，并用来討論居里点附近的相变性質。

利用双时溫度格林函数求得了磁化强度σ、居里点T_c、热力学势Ω以及其它热力学量。当外磁场不存在时，Ω及其一級微商 (熵 S = - $\frac{\partial \Omega}{\partial T}$) 在居里点連續，但二級微商 (比热 C_v = $= -T \frac{\partial^2 \Omega}{\partial T^2}$) 有一跳跃，这就給出了鐵磁体在居里点发生二級相变的微观解释。本文的計算結果与实验及分子場理論相符合。

A12. 含順磁杂质超导体中的束缚态

于 涣 (科学院物理所)

本文中利用广义正則变换和自洽場方法討論了单个杂质对超导体的影响。

計算表明，磁性杂质除引起連續譜中无激发波函数的畸变外还能形成一个束缚态的无激发，其能級位于能隙之中。在交換作用較弱的条件下：

$$\omega_0 = \Delta_0 \left(1 - \frac{2J_0'^2 S_z^2}{(1 + V_0')^2} \right)$$

Δ_0 是能隙， V_0' ， J_0' 是无量綱的散射勢和交換积分， S_z 是局域自旋。

相应的波函数是：

$$A \left[\frac{\sin k_F r}{k_F r} - V_0' \frac{\cos k_F r}{k_F r} \right] e^{-\sqrt{\Delta_0^2 - \omega_0^2} \frac{r}{v_F}}$$

A 是归一常数， v_F 、 k_F 是費米速度和費米动量。

我們計算了束缚能級所引起的附加电磁吸收。由于波函数扩展范围很大，附加吸收虽正比于杂质浓度，但系数很大。在主吸收边界前可能出現一个附加吸收峯。

文中还討論了与束缚能級存在有关的隧道效应和高頻吸收实验。

此外，本文中还討論了連續譜无激发在杂质場中所产生的畸变及所引起的能隙的变化。計算表明，能隙相对变化是較小的，且随距离增大衰減很慢 (r^{-2})。

A13. 超导薄膜的临界磁场理論

吳杭生 (北京大学物理系)

(1) 为了解释Douglass和Blumberg实验結果⁽¹⁾, 我們从理論上計算超导薄膜的临界磁场 H_0 (在 T_c 附近)。設膜的厚度为 d , 长寬各为 L ($L \gg d$)。設磁場沿着 r_3 方向, 相應的矢势为 $A(\underline{r})$ 。

(2) 首先, 我們把适用于无限大超导体的Горьков格林函数方程組⁽²⁾推广到薄膜的情形:

$$\left\{ i\omega + \frac{1}{2m} \left(D - ieA(\underline{r}) \right)^2 + U(\underline{r}) + \mu \right\} G_\omega(\underline{r}\underline{r}') + \Delta(\underline{r}) F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}') = \delta(\underline{r}-\underline{r}'), \quad (1)$$

$$\left\{ -i\omega + \frac{1}{2m} \left(D + ieA(\underline{r}) \right)^2 + U(\underline{r}) + \mu \right\} F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}') - \Delta^*(\underline{r}) G_\omega(\underline{r}\underline{r}') = 0,$$

$$\Delta^*(\underline{r}) = (g) + \sum_\omega F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}),$$

其中 $U(\underline{r})$ 代表薄膜的边界势能。 $G_\omega(\underline{r}\underline{r}')$ 和 $F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}')$ 满足如下边界条件:

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_\omega(\underline{r}\underline{r}')}{\partial r_1} \Big|_{r_1=\pm\frac{d}{2}} &= \frac{\partial G_\omega(\underline{r}\underline{r}')}{\partial r'_1} \Big|_{r'_1=\pm\frac{d}{2}} = 0 \\ \frac{\partial F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}')}{\partial r_1} \Big|_{r_1=\pm\frac{d}{2}} &= \frac{\partial F_\omega^+(\underline{r}\underline{r}')}{\partial r'_1} \Big|_{r'_1=\pm\frac{d}{2}} = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

对于足够薄的膜 ($d < \xi_0 \sim 10^{-4}$ cm), $\Delta(\underline{r})$ 可以近似看成常数。利用文章⁽²⁾方法, 从 (1) 得到决定超导薄膜的临界磁场 H_0 的方程:

$$1 = \frac{1}{d} |g| T \sum_\omega \iint d\underline{l} d\underline{r}_1 \widetilde{G}_\omega^{(0)}(\underline{l}\underline{r}) \widetilde{G}_{-\omega}^{(0)}(\underline{l}\underline{r}). \quad (3)$$

上式中的积分是局限于薄膜的内部, 又 $\widetilde{G}_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{r}')$ 满足类似 (2) 的边界条件, 它是由下 方程定义的:

$$\begin{aligned} \left\{ i\omega + \frac{1}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r_1^2} + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial}{\partial r_2} - ieH_0 r_1 \right)^2 + \frac{1}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r_3^2} + \right. \\ \left. + U(\underline{r}) + \mu \right\} \widetilde{G}_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{r}') = \delta(\underline{r}-\underline{r}'). \end{aligned} \quad (4)$$

(3) 我們对方程 (4)的解进行了分析, 得到如下結論: 方程 (4)的准經典近似解⁽²⁾, 只有对无限大超导体适用, 对于薄膜 $\widetilde{G}_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{r}')$ 应当采用如下表达式,

$$\widetilde{G}_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{r}') = G_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{r}') + \frac{ieH_0}{m} d\underline{l} G_\omega^{(0)}(\underline{r}\underline{l}) l_1 \frac{\partial}{\partial l_2} G_\omega^{(0)}(\underline{l}\underline{r}') +$$

$$+ \left(\frac{ieH_0}{m} \right)^2 \iint d\mathbf{l} d\mathbf{s} G_{\omega}^{(0)}(\mathbf{rl}) l_1 \frac{\partial}{\partial l_2} G_{\omega}^{(0)}(\mathbf{l s}) s_1 \frac{\partial}{\partial s_2} G_{\omega}^{(0)}(\mathbf{s r}) + \\ + \dots, \quad (5)$$

其中：

$$G_{\omega}^{(0)}(\mathbf{r r}') = \iint \frac{dp dq}{(2\pi)^2} \sum_k \frac{1}{i\omega - \xi_{kpq}} e^{ip(r_2 - r'_2) + iq(r_3 - r'_3)} \psi_k(\mathbf{r}_1) \psi_k(\mathbf{r}'_1), \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \psi_k(\mathbf{r}_1) &= \sqrt{\frac{1}{2d}} \quad (k=0), \\ &= \frac{1}{d} \cos k \left(r_1 - \frac{d}{2} \right) \quad (k \neq 0). \end{aligned} \quad (6a)$$

(4) 把 (5) 代入 (3)，保留到 H_0^4 项，计算得到薄膜的临界磁场是：

$$H_0 = \sqrt{\frac{32\pi r}{3\xi(s)}} \frac{1}{ed^{3/2} \xi_0^{1/2} (1-\mu(x))^{1/2}} (\Delta t)^{1/2} \left\{ 1 + \epsilon(\Delta t) \right\} \quad (7)$$

其中 $\Delta t = 1 - \frac{T}{T_c}$, $\xi_0 = 0.18 \frac{v_0}{kT_c}$, $r = lnc$ (c 是 Euler 常数), $\xi(5)$ 是黎曼 ζ -函数, $\mu(x) = 0.54 \times \left\{ \ln \frac{1}{x} + 1.27 - 0.195 x^3 \right\}$, $x = 0.361 \frac{d}{\xi_0} \left(\frac{T_c}{T} \right)$, 又 ϵ 是与 d 有关的正数。

依照Ландау-Гинзбург理論, 薄膜的临界场 H_0 是与 $\frac{1}{d}$ 成正比, 而 $(\Delta t)^{3/2}$ 系数 $\epsilon = -0.75$ 。

把 (7) 和 Douglass-Blumberg 实验结果比较, 在 $\xi_0 = 1.9 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 时, 理论和实验很好符合。

(5) 我们还准备对改进Ландау-Гинзбург理論問題进行研究。

参 考 文 献

- (1) D. H. Douglass Jr. and R. H. Blumberg Phys. Rev. 127 (1962) 2038
- (2) Горьков ЖЭТФ 36 (1959) 1918

A14. 杂质对超导体转变温度的影响

孙鑫 阮可妃 叶令 (复旦大学 物理系)

提出杂质超导体中传导电子与杂质原子的相互作用机构, 并用来解释磁性和非磁杂质引起超导体转变温度改变的实验现象。

在杂质超导体中, 传导电子一方面受到杂质原子的散射:

$$H_s' = \sum_{kk'} T_{kk'} a_{k\sigma}^+ a_{k'\sigma},$$

一方面还与杂质原子中束缚电子相互作用，将它二次量子化后可分为交换作用 H'_e 与直接作用 H'_d 两部分：

$$H'_d = \sum'_{kk'} \sum_l e^{-i(k-k')} \cdot R_l (I_{kk'} - \frac{1}{2} J_{kk'}) a_{k\sigma}^+ a_{k'\sigma}$$

$$H'_e = - \sum'_{kk'} J_{kk'} \left[a_{k\downarrow}^+ a_{k'\downarrow} S_{k-k'}^+ + a_{k\downarrow}^+ a_{k\uparrow} S_{k'-k}^- + (a_{k\downarrow}^+ a_{k'\downarrow} - a_{k\uparrow}^+ a_{k'\uparrow}) S_{k-k'}^z \right]$$

因而杂质超导体的总哈密顿量为：

$$H = H_{Fr} + H'_{im}$$

$$\text{即 } H = \sum_{k\sigma} \varepsilon_k a_{k\sigma}^+ a_{k\sigma} + \sum_q \omega_q b_q^+ b_q + \sum_{k', k=q} g \left(\frac{\omega_q}{2v} \right)^{\frac{1}{2}} a_{k\sigma}^+ a_{k'\sigma} (b_q^+ + b_{-q}) + H' s + H' d + H' e$$

从此哈密顿出发，利用u v变换和变分法（或抵消危险图）⁽¹⁾，根据超导介的存在条件求得了杂质超导体的转变温度 T_c 为：

$$T_c = T_c^0 \exp \left[\frac{1.12Dv}{\rho k T_c} \left[m^2 (I_0 - \frac{1}{2} J_0)^2 + t^2 - J_0^2 S(S+1) \right] \right]$$

因而交換作用 J_0 將使 T_c 下降，这是由于交換作用使传导电子自旋反向，折散了“Cooper对”的緣故。而散射 t 和直接作用 I_0 將使 T_c 上升，这是因为散射作用会間接地在传导电子間产生附加吸引力。

將鑭系稀土元素（順磁杂质）加入超导体鑭中时⁽²⁾，週期性勢場畸变很小且直接作用受到屏蔽，交換作用占优势，因而使 T_c 下降。并存在着杂质的临界浓度

$$D_c = \frac{0.035}{S(S+1) - m^2/4}$$

將过渡元素（鐵磁杂质）加入超导体鉢中时⁽³⁾，当直接作用 I_0 足够大时，促使 T_c 上升。对于非磁杂质⁽⁴⁾⁽⁵⁾，如果交換作用大于散射和直接作用，则 T_c 下降，反之， T_c 将上升。理論的計算与实验的結果基本符合。

参 考 文 献

- (1) Д. Н. Зубарев, ДАН СССР, 122, 6, (1958), 999.
- (2) В. Т. Matthias, Phys. Rev. Lett. 1. (1958). 92.
- (3) В. Т. Matthias, Phys. Rev. 115, 6, (1959), 1597.
- (4) E. A. Lynton. J. Phys. Chem. Solids. 3, (1957). 165.
- (5) D. J. Quiun. Phys. Rev. 123, 2, (1961) 466.

A15. 关于超导金属的 Knight 移动

蔡建華 徐定藩 毛鎮道（南京大学物理系）

自从吉田⁽¹⁾在BCS理論⁽²⁾的基础上用微扰論得出在絕對零度超导金属的Knight移动K等于零的結果后，许多人寻求各种因素来解释K不等于零的实验数据^[3]。其中主要有Pippard, Cooper 等⁽⁴⁾遵循的不精确配对的途径和Anderson, Горьков等⁽⁵⁾遵循的考慮自

旋軌道互作用的途径。本文嘗試討論引入這些因素是否必要，也就是探討在BCS理論本身的範圍以內是否一定會得出在絕對零度 $K=0$ 的結果。

為了不用微擾論，我們遵從的途径是直接從均勻磁場中的單電子態⁽⁶⁾出發，在以這些態為基底的二次量子化表象中利用中島變換⁽⁷⁾確定由交換聲子而導致的電子-電子互作用，然後按照BCS用變分法決定互作電子系統的平衡態，從而計算了超導態的磁化強度和磁化率 χ_s ，後者與正常態數值 χ_n 的比給出了 K 。

這裡主要之點是：根據在均勻磁場中單電子的能級來計算其態密度時，我們發現電子軌道動量矩沿磁場方向分量為正或負的狀態數不等。利用WKB近似來確定磁量子數 m 的最大許可絕對值後得到

$$\text{電子能量本征值 } \varepsilon = (2n_r + m + |m| + 1)\hbar\omega_L + \frac{p^2}{2\mu}, \quad \omega_L = \frac{eH}{2\mu c} \quad (1)$$

$$\text{態密度 } g(\varepsilon) = \frac{L}{2\pi\hbar} g(\varepsilon, p), \quad g(\varepsilon p) = g_+(\varepsilon p)_+ - g_-(\varepsilon p)_- = \frac{\mu\omega_L}{\hbar} R^2 \quad (2)$$

$$g_+(\varepsilon, p) = n + 1, \quad g_-(\varepsilon, p) = \frac{\mu\omega_L}{\hbar} R^2 - (n + 1), \quad n = \frac{\varepsilon - p^2/2\mu - \hbar\omega_L}{2\hbar\omega_L} \quad (3)$$

這裡我們假設超導金屬樣品為圓柱形，磁場 H 在其軸向， L 為圓柱長， R 為其半徑， μ 為電子動量， p 為電子沿磁場方向動量， n_r 為徑向量子數， g_+ 為 $m \geq 0$ 的狀態數而 g_- 為 $m < 0$ 的狀態數。

我們採用按 (n, m, p, σ) $(n, -m, -p, -\sigma)$ 配對⁽⁸⁾。於是可能配成的電子對數顯然將與磁場有關，這將使一部份電子態沒有對偶，因而會影響磁化率。遵照BCS我們依據如下的考慮來選取變分波函數：在 $T \neq 0$ 時可能有 (i) 处於基態的電子對，(ii) 激發對，(iii) 獨自沒有配成對的電子和(iv) 处於根本不可能配成對的狀態的電子。使自由能（由於哈密頓量已含有磁場，這其實已是吉勃斯函數）極小化求得平衡態電子分佈，再由自由能對磁場偏微分得到磁化強度。我們的結果如下：

$$K = \frac{\chi_s}{\chi_n} = \frac{(3\pi^2)^{1/3}}{192\pi} \frac{L}{(V/z)^{1/3}} \frac{1}{N^{2/3}} \left(\frac{\epsilon_F}{\mu_0 H} \right)^4, \quad \text{當 } T \rightarrow 0^\circ K \quad (4)$$

其中 V 為金屬原子體積， z 為原子價， N 為亞佛加德羅常數， ϵ_F 為費米能， μ_0 為玻爾磁子。以 S_n 的數據代入，並取 L 為穿透深度 5×10^{-6} cm， $H = 1400$ gauss（在實驗⁽³⁾所用磁場強度範圍以內）得 $K = 0.7$ 與實驗數據 $\frac{3}{4}$ 接近。

因此我們的結論是在BCS理論本身範圍內，充份考慮磁場因素，有可能解釋實驗結果。必須指出(4)式的一個重要缺點是 K 依賴於 H 較為強烈，這一點與目前實驗存在分歧。

參 考 文 獻

- (1) Yosida, Phys. Rev. 110 769, (1958).
- (2) Bardeen, Cooper and Schriffer, Phys. Rev. 108 1175 (1957).
- (3) Knight, Androes and Hammond, Phys. Rev. 104 852 (1956).
Reif, Phys. Rev. 106 208 (1957).
- (4) Androes and Knight, Phys. Rev. 121 779 (1961).
- (4) Heine and Pippard, Phil. Mag. 3 1046 (1958).
Cooper, Phys. Rev. Lett. 8 367 (1962).

- (5) Anderson, Phys. Rev. Lett. **3** 325 (1959).
 Абрикосов и Горьков, ЖЭТФ **42** 1088 (1962).
- (6) Sondheimer and Wilson, Proc. Roy. Soc. **A210** 173 (1951).
- (7) Bardeen and Pines, Phys. Rev. **99** 1140 (1955).
- (8) 关于这样配对的可能性見
 Oliphant and Tobocman, Phys. Rev. **119** 502 (1960).
 Anderson, J. Phys. and Chem. of Solids **11** 26 (1960).

又可参考

Вонсовский, ДАН, СССР **122** 204 (1958)
 ЖЭТФ, **39** 384 (1960).

A16. 推广的等效自旋哈密頓

林福成 祝繼康 (中国科学院电子所)

本文用羣論的方法提出了一种推广的等效自旋哈密頓，用它来描述晶体中过渡族离子的順磁共振性質。这种描述形式是基于下述的思想：如果順磁离子的基态能級組有 $2S + 1$ 个能級，那么自旋空間的不可約張量組 T_{LM} ($L = 0, 1, \dots, 2S$) 可以完全地描述順磁离子的行为。对于零場分裂部分 \hat{H}_s^0 ，利用哈密頓的厄米性和時間反演特性，得到 L 只能取偶数。 \hat{H}_s^0 是由順磁离子所处环境对称点羣的么表示的基构成的。对于跟磁場有关的部分 \hat{H}_s^1 ， L 只能取奇数。利用有限点羣的 Wigner-Eckart 定理，得到普通的自旋哈密頓所沒有的項，这些項包含自旋算符的高次多項式。 \hat{H}_s^1 是晶体点羣的某些不可約表示的基的綫性組合，这些不可約表示就是以 S_x , S_y 和 S_z 为基的不可約表示。

Koster 和 Statz 在 1959 年提出了一种描述晶体中順磁离子的塞曼能級的新形式——K-S 矩陣 (Koster-Statz 矩陣)，我們証明了推广的等效自旋哈密頓跟 K-S 矩陣是完全等价的。

把晶体点羣的不可約表示的基認為是点羣的不可約張量，我們对点羣 D_4 , D_{4v} , D_{2d} , D_3 , C_{3v} , D_6 , C_{6v} , D_{3h} , D_2 , C_{2v} , C_3 , O 和 T_d 在 $L \leqslant 5$ 的張量組 T_{LM} 中求出了对应于么表示和由 S_x , S_y 和 S_z 构成的不可約表示的不可約張量，并列成表，以便于求出推广的等效自旋哈密頓。

作为理論是否正确的检验和应用，我們推导了 Bleaney 在 1959 年提出的 U' 線的自旋哈密頓和 $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{Cl}^{3+}$ 的推广的等效自旋哈密頓，后者經過波函数相位的适当調節，可以跟 Statz 和 Koster 得到的矩陣完全一致。

利用推广的等效自旋哈密頓來計算跃迁几率和順磁共振綫型时，跟普通的自旋哈密頓有一些区别。

推广的等效自旋哈密頓能够描述大多数順磁离子的性質，如，3d族軌道单态、所有以 Kramers 双态为基态的离子和 S 态离子。其中几乎包括了所有的量子順磁放大感兴趣的晶体。

推广的等效自旋哈密頓虽然跟 K-S 矩陣完全等价，但是在晶体点羣是高对称度的点羣时，求推广的等效自旋哈密頓比求 K-S 矩陣方便，并且在形式上容易跟通常的自旋哈密頓比較，为实验决定其中的参数提供了方便。